

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月14日
Date of Application:

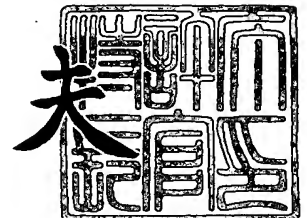
出願番号 特願2002-330399
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2002-330399]

出願人 株式会社東芝
Applicant(s):

2003年10月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3080789

【書類名】 特許願

【整理番号】 APB0290071

【提出日】 平成14年11月14日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 29/78
H01L 21/28
H01L 27/092
H01L 21/8238

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【請求項の数】 18

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝
横浜事業所内

【氏名】 宮野 清孝

【特許出願人】

【識別番号】 000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100097629

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹村 壽

【電話番号】 03-3843-4628

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004961

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体基板と、

半導体基板に形成されたソース／ドレイン領域と、

前記ソース／ドレイン領域間のチャネル領域上に形成されたゲート絶縁膜と、

前記ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極と、

前記半導体基板上に形成され、前記ゲート電極の側壁に形成された側壁絶縁膜とを具備し、

前記ゲート電極は、SiGe からなり、前記ゲート電極側壁には前記ゲート電極表面を酸化して得られる側壁絶縁膜が形成され、且つこの側壁絶縁膜はシリコン酸化膜を主成分とすることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 前記側壁絶縁膜の Ge/Si 組成比が前記ゲート電極の Ge/Si 組成比より小さいことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】 前記側壁絶縁膜は、実質的にシリコン酸化膜からなることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 4】 SiGe 単結晶層が形成された半導体基板と、
半導体基板に形成されたソース／ドレイン領域と、
前記ソース／ドレイン領域間のチャネル領域上に形成されたゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極とを具備し、
前記チャネル領域は、前記 SiGe 単結晶層からなり、前記チャネル領域表面には前記 SiGe 単結晶層を酸化することにより得られるゲート絶縁膜が形成され、且つこのゲート絶縁膜は、シリコン酸化膜を主成分とすることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】 前記ゲート絶縁膜中の Ge/Si 組成比が、前記単結晶層中の Ge/Si 組成比より小さいことを特徴とする請求項 4 に記載の半導体装置。

【請求項 6】 前記ゲート絶縁膜は、実質的にシリコン酸化膜からなることを特徴とする請求項 4 に記載の半導体装置。

【請求項 7】 半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜上に第1の半導体と第2の半導体からなる導電膜を形成する工程と

、
前記第1の半導体及び第2の半導体を酸化する酸化剤及び前記第1の半導体及び第2の半導体を還元する還元剤を含む雰囲気中で熱処理を行って、前記導電膜上に前記第1の半導体の酸化膜を形成する工程とを備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項8】 前記第1の半導体及び第2の半導体がC、Si、Geのいずれからなることを特徴とする請求項7に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項9】 前記第1の半導体がSiであり、前記第2の半導体がGeであることを特徴とする請求項7に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記Siを酸化する酸化剤はH₂O、CO₂及びO₂の少なくとも1つからなり、前記Geを還元する還元剤はH₂及びCOの少なくとも1つからなることを特徴とする請求項9に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項11】 半導体基板にソース／ドレイン領域を形成する工程と、
前記ソース／ドレイン領域間のチャネル領域上にゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜上にSiGeからなるゲート電極を形成する工程と、
前記SiGeからなるゲート電極表面をSiを酸化する酸化剤及びGeを還元する還元剤を含む雰囲気中で熱処理により、Siの酸化膜からなる側壁絶縁膜を形成する工程とを具備したことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項12】 前記Siを酸化する酸化剤はH₂O、CO₂及びO₂の少なくとも1つからなり、前記Geを還元する還元剤はH₂及びCOの少なくとも1つからなることを特徴とする請求項11に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項13】 半導体基板上に少なくとも2種類の半導体からなる単結晶層を形成する工程と、

前記単結晶層の表面上に前記単結晶層に対する酸化種として還元剤及び酸化剤を含む雰囲気による熱酸化によって前記少なくとも2種類の半導体の内の1つの半導体の酸化膜からなる絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜上に電極を形成する工程とを具備したことを特徴とする半導体装置

の製造方法。

【請求項 14】 前記少なくとも 2 種類の半導体が C、Si、Ge いずれかより成ることを特徴とする請求項 12 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 15】 前記還元剤として、 H_2 、CO のうち少なくとも 1 つを含み、酸化剤として、 H_2O 、 CO_2 、 O_2 のうち少なくとも 1 つを含むことを特徴とする請求項 13 又は請求項 14 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 16】 半導体基板上にチャネル領域が形成される SiGe 単結晶層を形成する工程と、

前記チャネル領域が形成された半導体基板にソース／ドレイン領域を形成する工程と、

前記ソース／ドレイン領域間の前記チャネル領域上にゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する工程とを備え、

前記ゲート絶縁膜は、前記 SiGe 単結晶層表面に、Si を酸化する酸化剤及び Ge を還元する還元剤を含む雰囲気での熱処理により形成され、且つ実質的にシリコン酸化膜のみからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 17】 前記 Si を酸化する酸化剤は H_2O 、 CO_2 及び O_2 の少なくとも 1 つからなり、前記 Ge を還元する還元剤は H_2 及び CO の少なくとも 1 つからなることを特徴とする請求項 16 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 18】 前記雰囲気が、前記 Si を酸化する酸化剤として H_2O を用い前記 Ge を還元する還元剤として H_2 を用いる場合において、 H_2O と H_2 との分圧比 (P_{H_2O} / P_{H_2}) が $10^{-1} \sim 10^{-21}$ の範囲であり、前記熱処理の温度が $0^\circ K \sim 2500^\circ K$ の範囲であって、図 6 に示される GeO_2 の平衡水素水蒸気分圧曲線 (A) と SiO_2 の平衡水素水蒸気分圧曲線 (B) との間の領域内の分圧比を有することを特徴とする請求項 9 乃至請求項 12、請求項 15 乃至請求項 17 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、導電材料として少なくとも 2 種の半導体からなる、例えば、SiGe のような材料を用いた MOS トランジスタの構造及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

高性能の MOS トランジスタとして、その導電材料に SiGe を用いることが注目されている。例えば、図 11 に示すように、SiGe は、ゲート電極として、PMOS トランジスタの活性化率を向上させ、空乏化を抑制することができる。通常ゲート電極表面には、加工による RIE (Reactive Ion Etching) ダメージの回復や側壁絶縁膜を形成する目的で数 nm ~ 10 nm 程度の酸化膜（ここでは側壁酸化膜と呼ぶ）が形成される。さらに、SiGe 電極を用いる世代になると、側壁酸化膜は、ドーパントの外方拡散を抑制する役割を併せ持つことになる。

【0003】

また、例えば、図 12 に示すように、MOS トランジスタではチャネル領域のキャリア移動度を高めるために、SiGe 層をエピタキシャル成長させて SiGe チャネル層とする構造が有望視されている。この MOS トランジスタは、通常の MOS トランジスタと同様に SiGe チャネル形成後、ゲート酸化膜が形成される。この場合 SiGe の酸化であるため、ゲート酸化膜中には SiO₂ と GeO₂ が含まれることになる。ところが、この SiGe の酸化により形成される SiO₂ と GeO₂ を比較すると、前述のように GeO₂ は、耐薬品性で SiO₂ より劣っており、且つ SiO₂ よりも揮発性が高い。したがって、ゲート酸化膜形成後の薬液処理や熱処理によりゲート酸化膜は、ダメージを受ける。ゲート酸化膜の薄膜化がさらに進むとこの問題はより顕在化することになる。なお、SiGe 膜をゲート電極に用いることは特許文献 1 に記載されている。

【0004】

【特許文献 1】

特開 2002-26318 号公報（図 1、2 ~ 3 頁）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、SiGeを酸化して形成されるSiO₂とGeO₂とを比較すると、GeO₂は、H₂O₂、H₂SO₄、HF等の耐薬品性がSiO₂より劣っており、且つSiO₂よりも揮発性が高い。したがって、側壁酸化膜形成後の薬液処理や熱処理により側壁酸化膜は、ダメージを受けてドーパントの外方拡散抑制効果が低下するという問題があった。また、前述のように、GeO₂が耐薬品性でSiO₂より劣っており、且つSiO₂よりも揮発性が高いところから、ゲート酸化膜形成後の薬液処理や熱処理によりゲート酸化膜は、ダメージを受ける。ゲート酸化膜の薄膜化がさらに進むとこの問題はより顕在化することになる。

本発明は、このような事情によりなされたものであり、少なくとも2種類の半導体からなる半導体層、例えば、SiGeを導電材料として用いるMOSトランジスタにおいて、前記少なくとも2種類の半導体からなる半導体層、例えば、SiGeの表面を所望の形状に酸化処理を施す半導体装置及びこの酸化処理を効率的に行うことができる製造方法を提供するものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】

第1の発明は、半導体基板上に形成された絶縁膜上に第1の半導体と第2の半導体からなる導電膜を形成し、次に、前記第1の半導体が酸化し前記第2の半導体が酸化しない雰囲気中で熱処理を行って、前記導電膜上に前記第1の半導体の酸化膜を形成することを特徴としている。例えば、SiGeを導電材料として用いるMOSトランジスタにおいて、SiGeの表面にシリコン酸化膜のみを形成することを特徴とし、SiGeの酸化処理において、シリコンが酸化され、ゲルマニウムが還元される雰囲気中で処理が行われることを特徴としている。例えば、SiGeゲート電極の側壁酸化において、酸化種として還元剤及び酸化剤を含む系、例えば、H₂及びH₂Oを含む雰囲気或いはCO及びCO₂を含む雰囲気等を用いて、シリコンは酸化され、Geは還元される分圧比PH₂/PH₂O或いはPCO/PCO₂の範囲で選択酸化を行う。これはSiO₂、GeO₂の標準生成自由エネルギーの計算結果から得られるものである。

【0007】

SiGeの選択酸化により、側壁酸化膜としてSiO₂のみが形成されるため

側壁酸化膜形成後の薬液処理や熱処理耐性の高い側壁酸化膜がえられ、ドーパントの外方拡散を効果的に抑制することができる。ゲート電極の側壁酸化は、主としてゲート電極加工時のR I Eにより、半導体基板側ゲートエッジ部に入るダメージを除去するために行われる。また、側壁酸化は、ゲート電極中のドーパントがその後の活性化アニール等の熱処理により外方拡散することを抑制するバリア層としての働きを併せ持っている。S i G eをゲート電極に用いる世代のM O Sトランジスタでは、ゲート空乏化を抑制する目的からゲート電極中に高い濃度のキャリアが必要とされる為、外方拡散抑止効果がより重要となってくる。さらに、微細M O Sでは短チャネル効果抑止等の目的で、拡散領域へのイオン注入の際にゲート電極の位置とイオン注入箇所にもオフセットを設けるためのスペーサとして側壁酸化膜を用いる場合もある。

【0008】

従来、S i G eゲート電極を酸化するとS i O₂と同時にG e O₂が生成される。このG e O₂は熱処理により揮発しやすく、また半導体製造プロセス頻繁に用いられるH₂ O₂、H F等への耐薬品性がS i O₂に比して低いことが知られている。従って生成したS i O₂とG e O₂よりなる側壁酸化膜は、薬液処理や熱処理を経ると疎な膜となり、ドーパントの外方拡散抑制効果が著しく劣化してしまう。また、オフセットスペーサとして用いる場合も膜厚均一性が劣化してしまう等の問題を生じる。これに対して、本発明の半導体装置の製造方法により得られた半導体装置では、S i G eの選択酸化により側壁酸化膜としてS i O₂のみが形成されるため、側壁酸化膜形成後の薬液処理や熱処理耐性の高い側壁酸化膜を形成することができる。この結果、稠密で均一な側壁酸化膜によりドーパントの外方拡散を効果的に抑制することができ、拡散層イオン注入のオフセットも正確に制御できるようになる。

【0009】

第2の発明は、半導体基板上に少なくとも2種類の半導体からなる単結晶層を形成する工程と、前記単結晶層の表面上に前記単結晶層に対する酸化種として還元剤及び酸化剤を含む雰囲気による熱酸化によって絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に電極を形成する工程とからなることを特徴としている。例えば、S

i Ge チャンネル形成後のゲート酸化において、上記側壁酸化と同様に、シリコンは酸化されゲルマニウムは還元される分圧比 P_{H_2} / P_{H_2O} 或いは P_{CO} / P_{CO_2} の範囲で選択酸化を行う。SiGe の選択酸化により、ゲート酸化膜として SiO_2 のみ形成されるため、ゲート酸化膜形成後の薬液処理や熱処理耐性の高いゲート酸化膜を得ることができる。なお、SiGe は、化合物ではなく混晶であり、実際には $Si_{1-x}Ge_x$ と表現される。SiGe の Ge 濃度は、通常 2 ~ 50 atom% 程度である。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して発明の実施の形態を説明する。

本発明の第 1 の発明は、半導体基板上に形成された絶縁膜上に第 1 の半導体と第 2 の半導体からなる導電膜を形成し、これを前記第 1 の半導体が酸化し前記第 2 の半導体が酸化しない雰囲気中で熱処理を行って、実質的に前記第 1 の半導体のみの緻密な酸化膜を形成するというものである。

【0011】

まず、図 1 乃至図 6 を参照して第 1 の実施例を説明する。

図 1 乃至図 5 は、この実施例の相補型 MOS トランジスタ (CMOS FET) の製造工程断面図、図 6 は、シリコン (Si) 及びゲルマニウム (Ge) 酸化物の平衡水素水蒸気分圧の温度依存性を示す特性図であり、縦軸が H_2O と H_2 との分圧比 (P_{H_2O} / P_{H_2})、横軸が熱処理温度 (絶対温度) ($^{\circ}K$) を表し、 GeO_2 の平衡水素水蒸気分圧曲線 A と SiO_2 の平衡水素水蒸気分圧曲線 B が示されている。

【0012】

シリコン半導体基板 101 上にフォトリソグラフィ技術を用いて所望の領域にレジストパターンを形成し、これをマスクとして半導体基板 101 に B、Ga、或いは In をイオン注入する。同じ様に所望の領域にレジストパターンをマスクとして As、P 或いは Sb をイオン注入する。引き続き熱拡散を行うことにより基板表面からの深さ $1\mu m$ 程度の P 型不純物拡散領域 (P ウエル) 102 及び N 型不純物拡散領域 (N ウエル) 103 を形成する (図 1 (a))。次に、半導体

基板 101 表面の所定の領域にトレンチ (溝) を形成し、その中に膜厚 400 nm 程度の CVD (Chemical Vapour Deposition) 等により形成されたシリコン酸化膜を埋め込み、この領域を STI (Shallow Trench Isolation) 構造の素子分離領域 104 とする (図 1 (b))。次に、熱処理等により膜厚 10 nm 程度のシリコン酸化膜 105 を形成してこれを保護絶縁膜とする。その後、トランジスタのしきい値を合わせるためのイオン注入を行う (図 1 (c))。

【0013】

次に、シリコン酸化膜を剥離した後、再び数 nm 程度のゲート絶縁膜 106 を形成する。ゲート絶縁膜にはシリコン酸化膜 (SiO_2) の他、窒素を数%程度含んだオキシナイトライド膜やタンタル酸化膜 (TaO_2)、ジルコニウム酸化膜 (ZrO_x) やハフニウム酸化膜 (HfO_x) 等の高誘電率絶縁膜或いはそれらのシリケート等を用いても良い (図 2 (a))。次に、CVD 法等を用いて 150 nm 程度の SiGe 膜 107 を堆積させ、P 型不純物拡散領域 102 及び N 型不純物拡散領域にそれぞれ B、As 等をドーピングする (図 2 (b))。

次に、SiGe 膜 107 上にフォトレジスト 108 を塗布し、これをパターニングする。パターニングされたフォトレジスト 108 をマスクとして SiGe 膜 107 をエッチングし、エッチングされた SiGe 膜 107 からなるゲート電極を形成する (図 2 (c))。

【0014】

次に、フォトレジスト除去後、 H_2O と H_2 を用いた選択酸化技術により 2 nm 程度の側壁酸化膜 109 を形成する。ここで H_2O と H_2 の分圧比 $P_{\text{H}_2\text{O}}/P_{\text{H}_2}$ を図 6 に示す範囲内において酸化を行うことにより、 SiO_2 を生成し GeO_2 を生成しない選択酸化が可能となる (図 3 (a))。次に、半導体基板 101 上にフォトレジスト 110 を塗布し、これをパターニングする。パターニングされたフォトレジスト 110 により N 不純物拡散領域 103 のみをマスクし、As、1 keV、 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 程度のイオン注入により、浅い N 型不純物拡散領域 111 を形成する (図 3 (b))。

【0015】

同じようにして、フォトレジスト 110 を除去後、パターニングされたフォト

レジスト 110' をマスクにして、P 型不純物拡散領域 102 のみをマスクし、 BF_2 1.5 keV、 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 程度のイオン注入により、浅い P 型不純物拡散領域 112 を形成する。以上により LDD 構造構成する極浅の不純物拡散領域 111、112 を得る (図 4 (a))。フォトレジスト 110' を除去した後、膜厚 20 nm 程度のシリコン酸化膜 (SiO_2) 113 を、TEOS を用いた CVD により被覆性良く成膜し、引き続きこの成膜上に膜厚 20 nm 程度のシリコン窒化膜 (SiN) 114 を CVD より被覆性良く堆積させる (図 4 (b))。次に、積層されたシリコン酸化膜 113 及びシリコン窒化膜 114 を RIE (Reactive Ion Etching) 等の異方性エッチングによりエッチングして、ゲート電極側壁にシリコン酸化膜 113 及びシリコン窒化膜 114 の積層膜を残すようにする。これによりシリコン窒化膜 114 に覆われた SiGe ゲート電極が得られる (図 5 (a))。

【0016】

次に、フォトレジスト (図示しない) により N 型不純物拡散領域 103 のみをマスクし、P 型不純物拡散領域 102 に P (リン)、10 keV、 $3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 程度のイオン注入を行う。同様にフォトレジスト (図示しない) により P 型不純物拡散領域 102 のみをマスクし、N 型不純物拡散領域 103 に B、5 keV、 $3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 程度のイオン注入を行う。このとき不純物拡散領域と同時にゲート電極にもイオン注入が行われる。引き続き N_2 雰囲気において 1050℃、10 秒程度の活性化アニールを行い、N 型高濃度不純物拡散領域 115 及び P 型高濃度不純物拡散領域 116 を形成する。浅い N 型不純物拡散領域 111 及び N 型高濃度不純物拡散領域 115 は、P 型不純物拡散領域 (P ウェル) に形成されるトランジスタのソース/ドレイン領域を構成し、浅い P 型不純物拡散領域 112 及び P 型高濃度不純物拡散領域 116 は、N 型不純物拡散領域 (N ウェル) に形成されるトランジスタのソース/ドレイン領域を構成する。

【0017】

この活性化アニールにおいて、従来の側壁酸化を行った SiGe ゲート電極では、側壁酸化膜が十分にドーパントの外方拡散を抑制することができず、所望のキャリア濃度を実現することが困難であったが、この実施例の選択酸化を用いる

ことにより稠密な側壁酸化膜が形成されているため、ドーパントの外方拡散抑制効果が高く、ゲート電極中に高濃度のキャリアを保持することが可能となり、その結果ゲート空乏化の問題を回避することが可能となる。

これ以降の工程ではN i、P t等のサリサイドを用いても良いし、エレベーターッド (Elevated) ソース／ドレイン領域等を導入しても良く、公知の技術でコンタクト、配線等の形成を行って半導体装置を完成する。

【0018】

次に、図7乃至図10を参照して第2の発明に係る実施例（第2の実施例）を説明する。

図7乃至図10は、P型MOSトランジスタ (PMOSFET) の製造方法を示す工程断面図である。まず、シリコン半導体基板201上にS i G e層202をエピタキシャル成長させる。次に、フォトリソグラフィ技術を用いて所望の領域にレジストパターン（図示しない）を形成し、これをマスクとしてシリコン半導体基板にA s、P、S bなどをイオン注入する。引き続き熱拡散を行うことにより深さ1 μ m程度のN型不純物拡散領域203を形成する（図7（a））。次に、所定の領域に膜厚400 nm程度のシリコン酸化膜204を埋め込み、素子分離領域 (S T I) を形成する（図7（b））。

【0019】

次に、膜厚10 nm程度の保護酸化膜（シリコン酸化膜）205を形成し、トランジスタの閾値を合わせるためのイオン注入を行う（図7（c））。次に、酸化膜205を剥離した後に再び数nm程度のゲート絶縁膜206を形成する。ゲート絶縁膜の形成には、酸化種として還元剤及び酸化剤を含む系、例えば、H₂及びH₂ Oを含む系もしくはC O及びC O₂ を含む系を用いる。ここで、これら酸化剤と還元剤の分圧比は、S iは、酸化されG eは還元される分圧比（P H₂ / P H₂ O或いはP C O / P C O₂）の範囲を適用し、この範囲で選択酸化を行う。これはS i O₂、G e O₂ の標準生成自由エネルギーの計算結果から得ることができる。

【0020】

図6は、この分圧比（平衡水素水蒸気分圧比）と温度の関係を示したグラフで

ある。縦軸が分圧比 P_{H_2} / P_{H_2O} を表し、横軸が温度 ($^{\circ}K$ (絶対温度)) を表している。この図 6 において、 GeO_2 の平衡水素水蒸気圧分圧曲線 A 及び SiO_2 の平衡水素水蒸気圧分圧曲線 B に挟まれた範囲に相当する分圧比及び温度 ($^{\circ}K$) を選択することにより、 SiO_2 からなる酸化膜中に GeO_2 を含まない酸化膜を形成することができる。ゲート絶縁膜には SiO_2 膜の他に、窒素を数%程度含んだオキシナイトライド膜や TaO_x 、 ZrO_x や HfO_x 等の高誘電体、或いはそれらのシリケート等を用いても良い。当然これらのベース酸化膜として用いる熱酸化膜は、上記の選択酸化方法を適用して形成する (図 8 (a))。

【0021】

次に、CVD 法等を用いて膜厚 150 nm 程度の多結晶 Si 膜 207 を堆積し、膜中に B、 BF_2 等をドーピングする (図 8 (b))。次に、フォトレジスト 208 をマスクとして多結晶 Si 膜をエッチングし、多結晶 Si ゲート電極 207 を得る。引き続きフォトレジスト 208 を除去する。このとき従来の熱酸化により形成されたゲート絶縁膜 206 は、 GeO_2 を含み、これがレジスト除去に用いられる H_2O_2 、 H_2SO_4 に可溶なため、ゲート絶縁膜は疎な構造となってしまう、必要とされる電気的特性を満たさなくなってしまう。本発明では、選択酸化により SiO_2 のみを形成しているためこのような問題は生じない (図 8 (c))。

【0022】

次に、膜厚 2 nm 程度の側壁酸化膜 209 を形成する (図 9 (a))。次に、フォトレジスト 210 をマスクとして、 BF_2 1.5 eV 1 e15 cm⁻² 程度のイオン注入により、浅い P 型不純物拡散領域 210 を形成する。以上の工程により LDD と呼ばれる極浅の拡散領域を得る (図 9 (b))。次に、膜厚 20 nm 程度のシリコン酸化膜 (SiO_2) 211 を TEOS を用いた CVD により被覆性良く成膜し、引き続いて、膜厚 20 nm 程度のシリコン窒化膜 (SiN) 212 を CVD により被覆性良く堆積した後、RIE などによりゲート側壁にシリコン窒化膜を残す形でエッチングを行い (図 9 (c))、シリコン窒化膜 212 に覆われた多結晶 Si ゲート電極を得る (図 10 (a))。

次に、半導体基板 201 に $B \ 5 \text{ keV} \ 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 程度のイオン注入を行う。このとき不純物拡散領域 210 と同時にゲート電極 207 にもイオン注入が行われる。引き続いて、 N_2 雰囲気において、 1050°C 、10 秒程度の活性化アニールを行い、P 型不純物拡散領域 210 の下に P 型高濃度不純物拡散領域 213 を形成する（図 10（b））。

【0023】

これらの各種熱工程により、従来の酸化法で形成された酸化膜では、含まれる GeO_2 が揮発して疎な膜となり、耐圧等求められる電気的特性を満たさなくなってしまう。本発明では酸化膜中には SiO_2 のみを含むためこのような問題は生じない。

以降の工程では通常の Ni 、 Pt 等のサリサイドを用いても良いし、エレベेटッド (Elevated) ソース／ドレイン領域等を導入しても良く、公知の技術でコンタクト、配線等を行って MOS トランジスタを完成させる。

【0024】

【発明の効果】

以上の構成により、第 1 の発明は、第 1 の半導体と第 2 の半導体からなる導電膜、例えば、 $SiGe$ 表面に、第 1 の半導体、例えば、シリコン酸化物のみからなる緻密な酸化膜が形成される。また、例えば、 $SiGe$ の選択酸化により、側壁酸化膜として SiO_2 のみが形成されるため側壁酸化膜の形成後における薬液処理や熱処理耐性の高い側壁酸化膜がえられ、ドーパントの外方拡散を効果的に抑制することができる。また、例えば、 $SiGe$ の選択酸化により、 $SiGe$ 層上にゲート酸化膜として SiO_2 のみが形成されるため、ゲート酸化膜の形成後における薬液処理や熱処理耐性の高いゲート酸化膜を得ることができる。

第 2 の発明は、少なくとも 2 種類の半導体からなる単結晶層の表面上に前記単結晶層に対する酸化種として還元剤及び酸化剤を含む雰囲気による熱酸化によって第 1 の半導体が酸化され、第 2 の半導体が還元される選択酸化によりゲート絶縁膜として緻密な膜のみが形成されるため、ゲート絶縁膜形成後の薬液処理や熱処理耐性の高い絶縁膜となり、高ゲート耐圧等の所望の電気特性を得ることができ、また、ゲート電極からチャネル領域へのドーパントの拡散を効果的に抑制す

ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施例において説明する相補型 MOS トランジスタの製造工程断面図。

【図 2】

本発明の第 1 の実施例において説明する相補型 MOS トランジスタの製造工程断面図。

【図 3】

本発明の第 1 の実施例において説明する相補型 MOS トランジスタの製造工程断面図。

【図 4】

本発明の第 1 の実施例において説明する相補型 MOS トランジスタの製造工程断面図。

【図 5】

本発明の第 1 の実施例において説明する相補型 MOS トランジスタの製造工程断面図。

【図 6】

シリコン（S i）及びゲルマニウム（G e）酸化物の平衡水素水蒸気分圧の温度依存性を示す特性図。

【図 7】

本発明の第 2 の実施例における P 型 MOS トランジスタ（PMOSFET）の製造方法を示す工程断面図。

【図 8】

本発明の第 2 の実施例における P 型 MOS トランジスタ（PMOSFET）の製造方法を示す工程断面図。

【図 9】

本発明の第 2 の実施例における P 型 MOS トランジスタ（PMOSFET）の製造方法を示す工程断面図。

【図 10】

本発明の第 2 の実施例における P 型 MOS トランジスタ (PMOSFET) の製造方法を示す工程断面図。

【図 11】

MOSFET の SiGe ゲート電極と側壁酸化膜を説明する構造模式図。

【図 12】

MOSFET の SiGe チャネルとゲート酸化膜を説明する構造模式図。

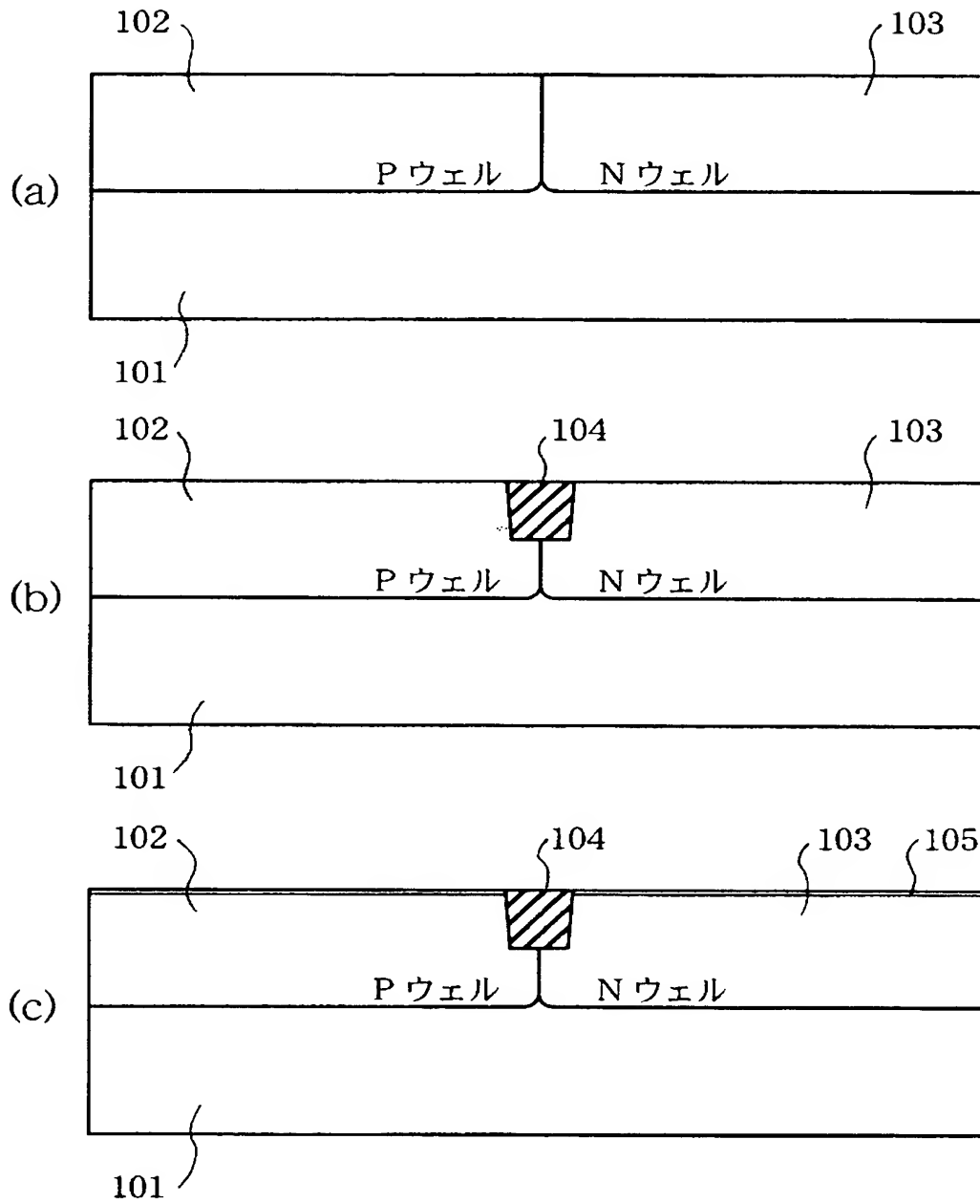
【符号の説明】

- 101、201・・・シリコン半導体基板
- 102・・・P 型不純物拡散領域 (P ウエル)
- 103、203・・・N 型不純物拡散領域 (N ウエル)
- 104、204・・・素子分離領域
- 105、205・・・シリコン酸化膜
- 106、206・・・ゲート絶縁膜
- 107・・・SiGe 膜
- 108、110、110'、208・・・フォトレジスト
- 109、209・・・側壁酸化膜
- 111・・・N 型不純物拡散領域
- 112、210・・・P 型不純物拡散領域
- 113、211・・・シリコン酸化膜
- 114、212・・・シリコン窒化膜
- 115、213・・・N 型高濃度不純物拡散領域
- 116・・・P 型高濃度不純物拡散領域
- 202・・・SiGe 層
- 207・・・Si 膜 (ゲート電極)

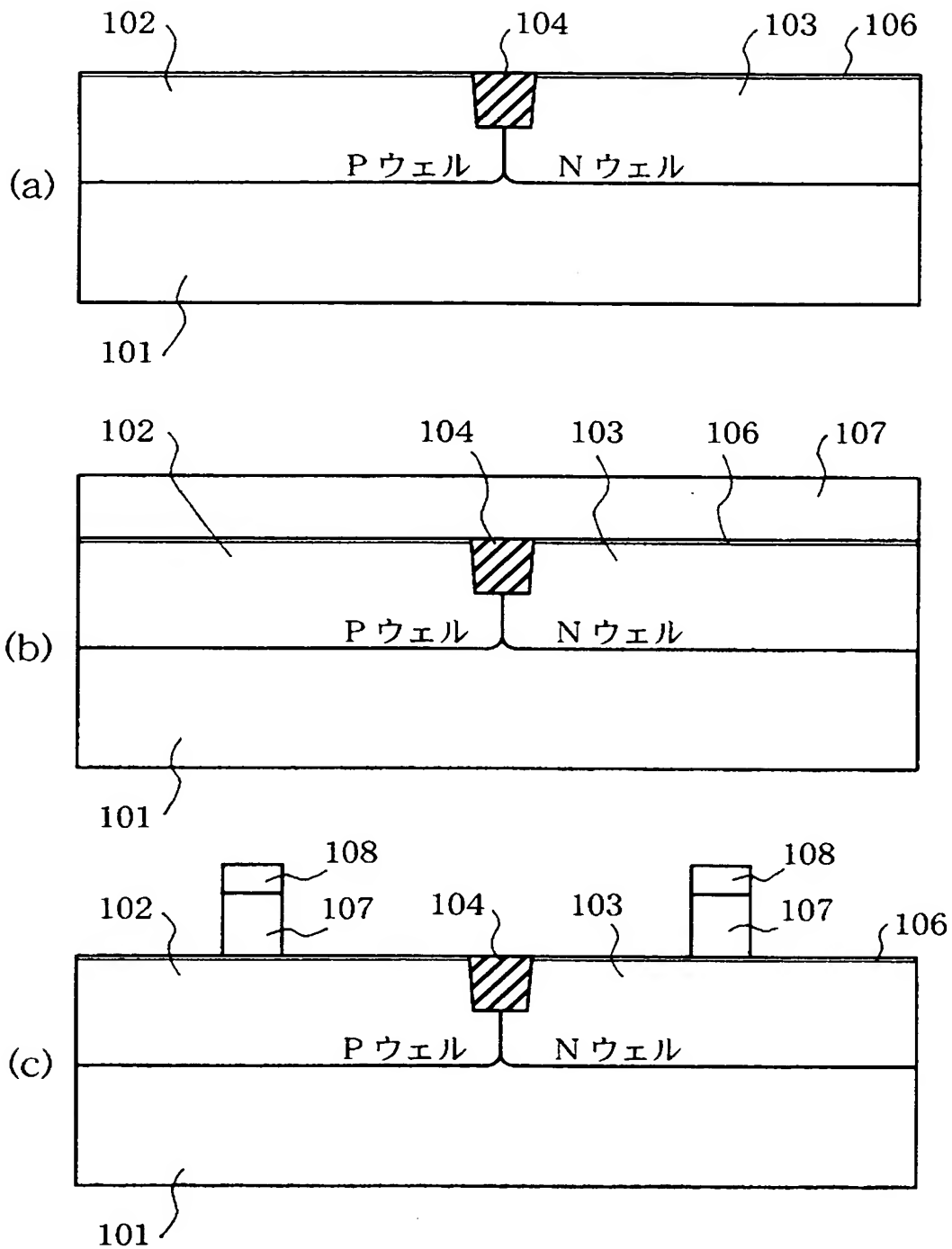
【書類名】

図面

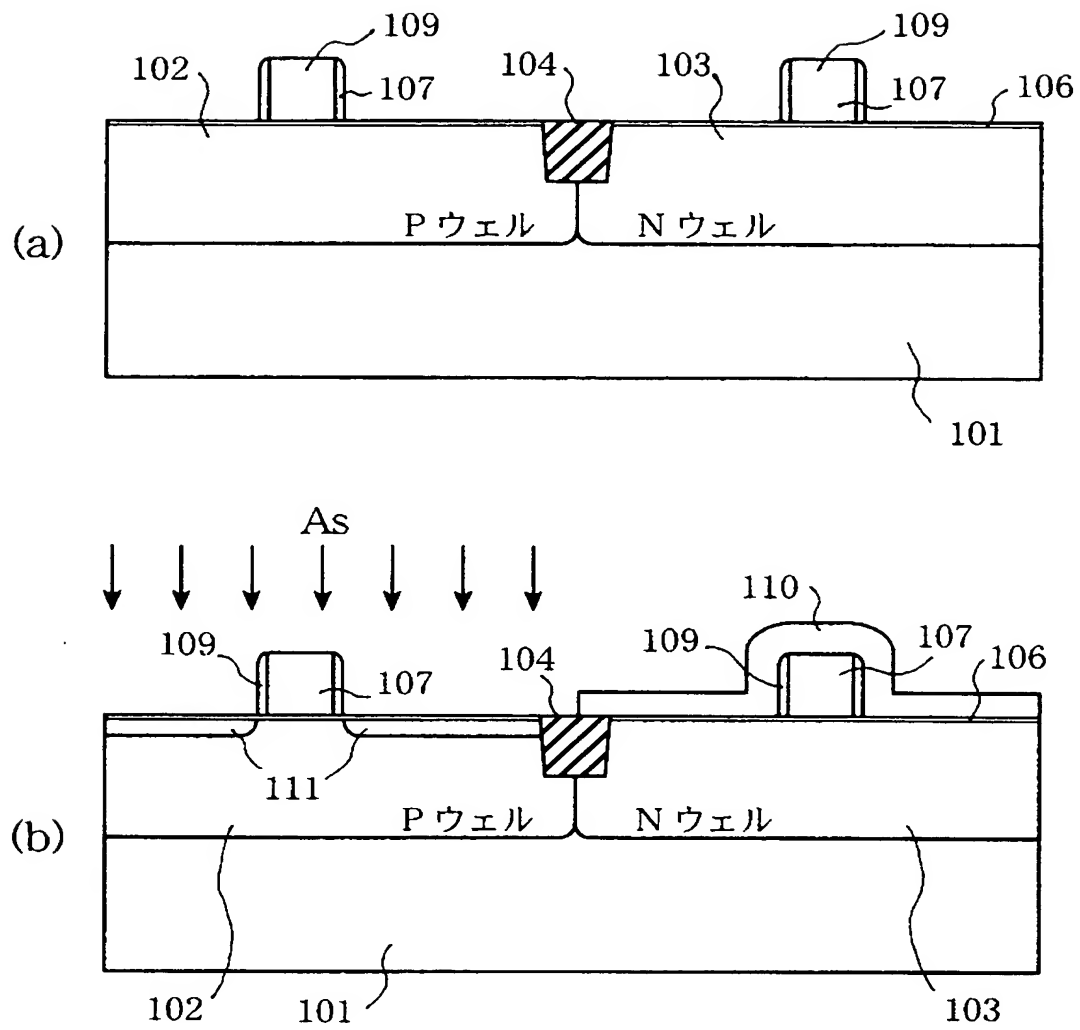
【図 1】



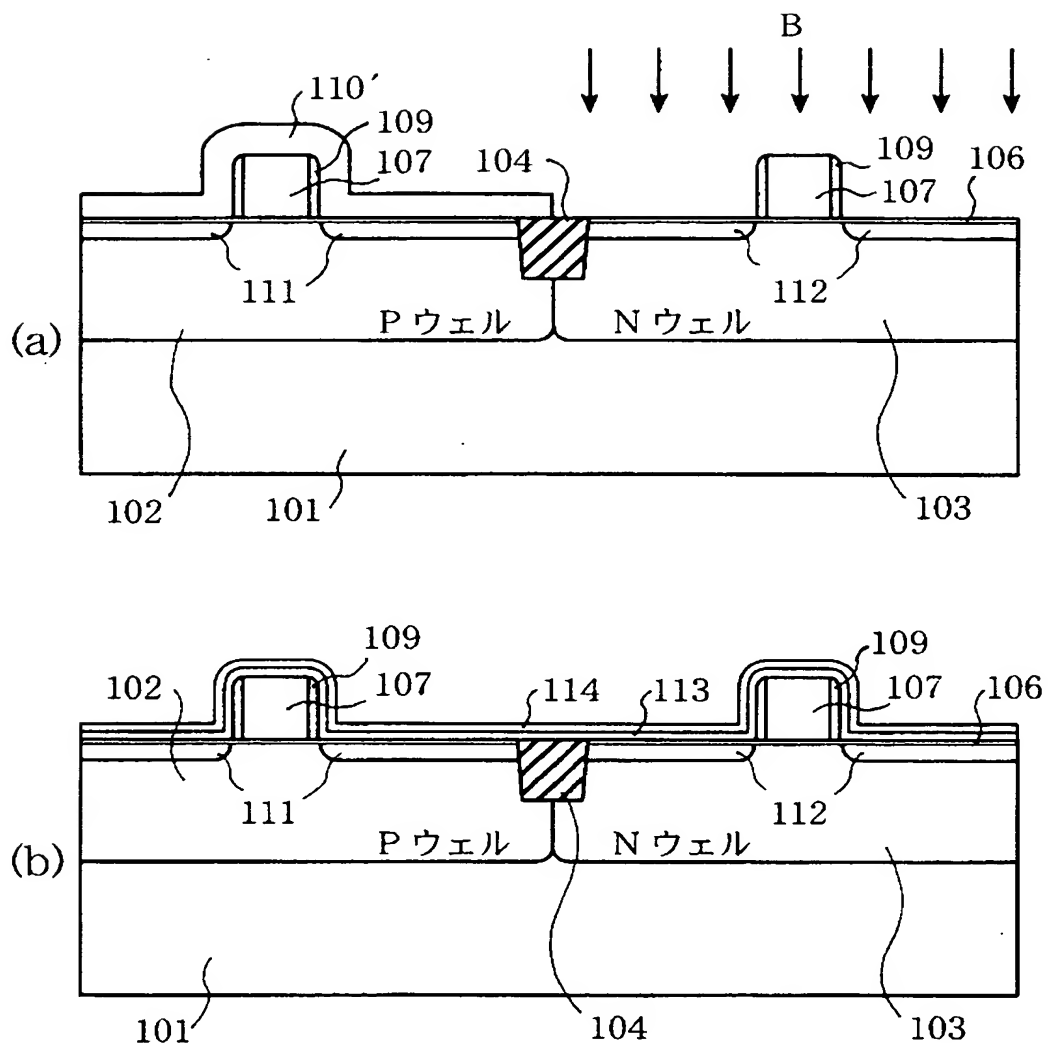
【図 2】



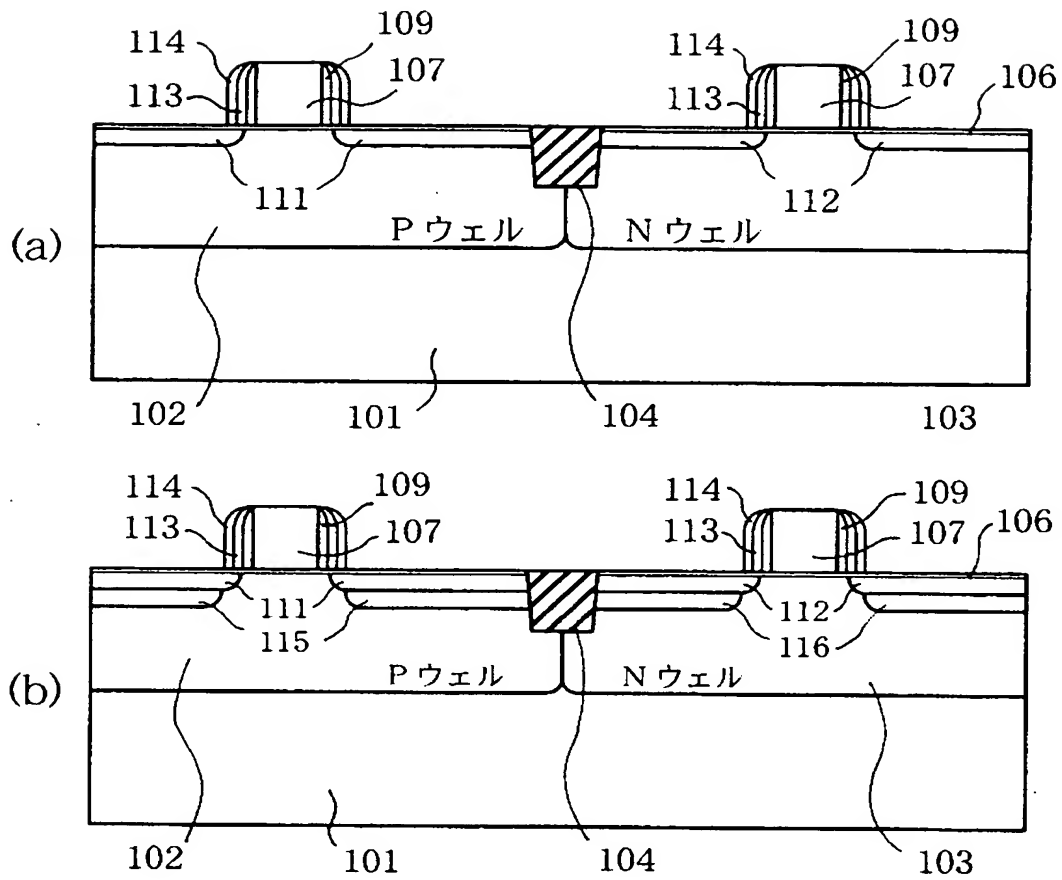
【図 3】



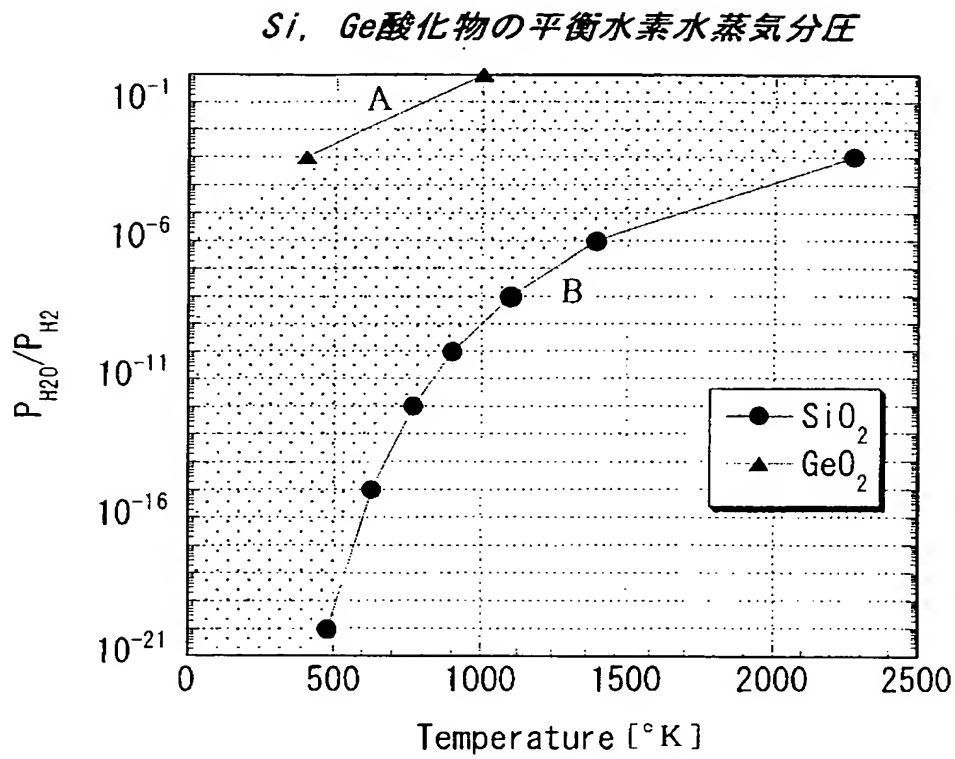
【図 4】



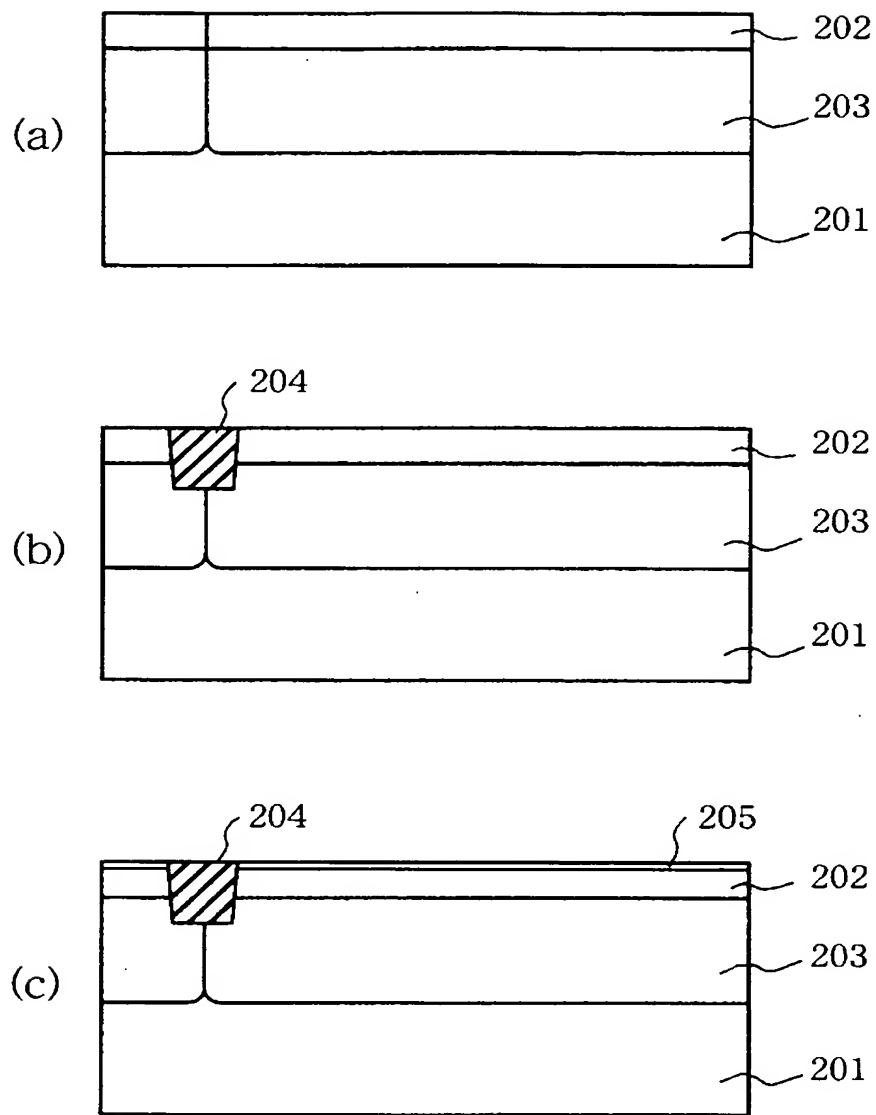
【図 5】



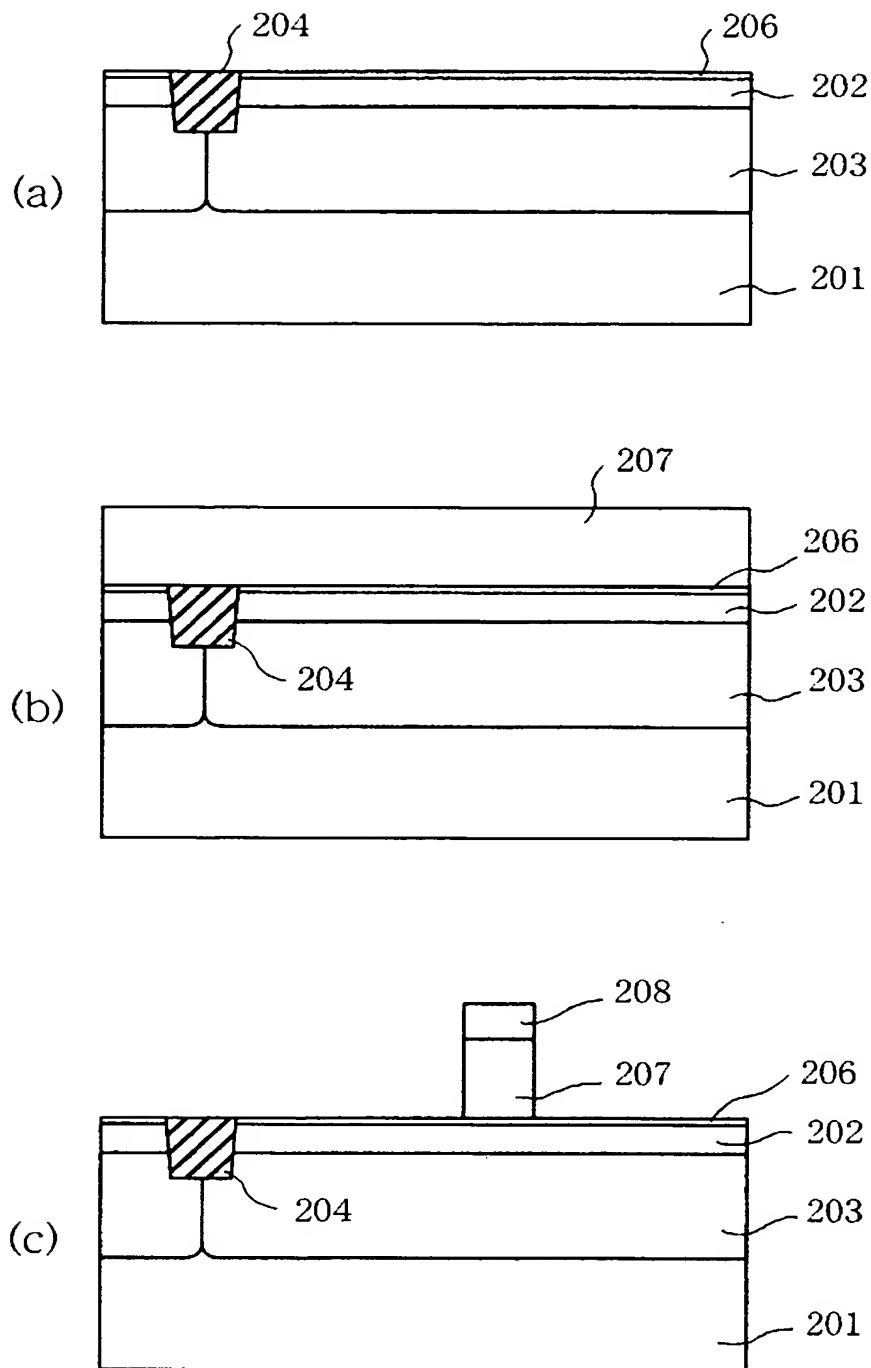
【図 6】



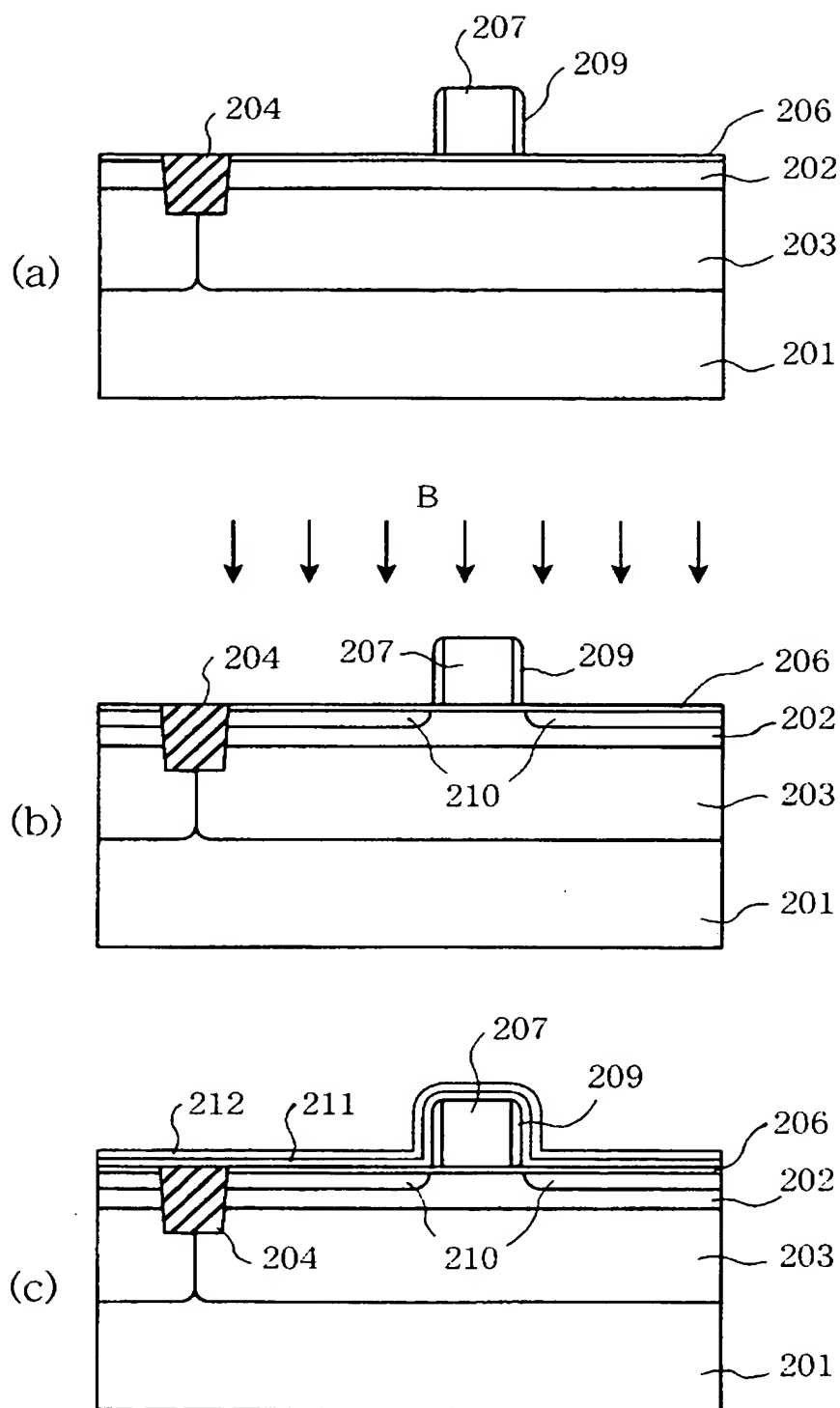
【図 7】



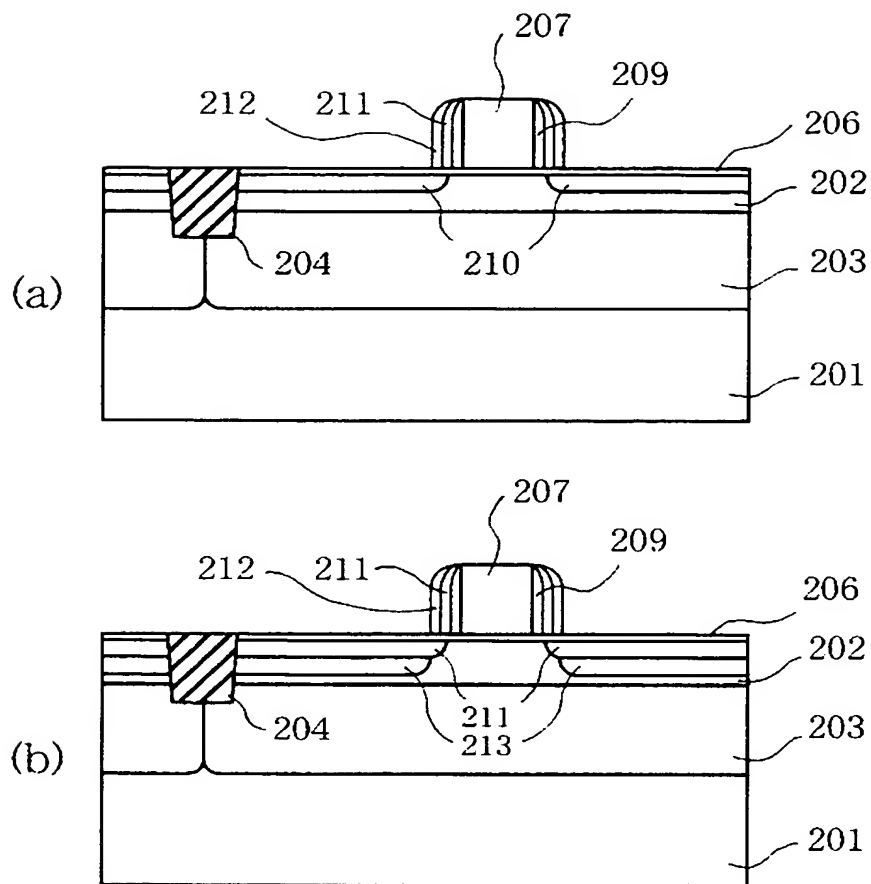
【図 8】



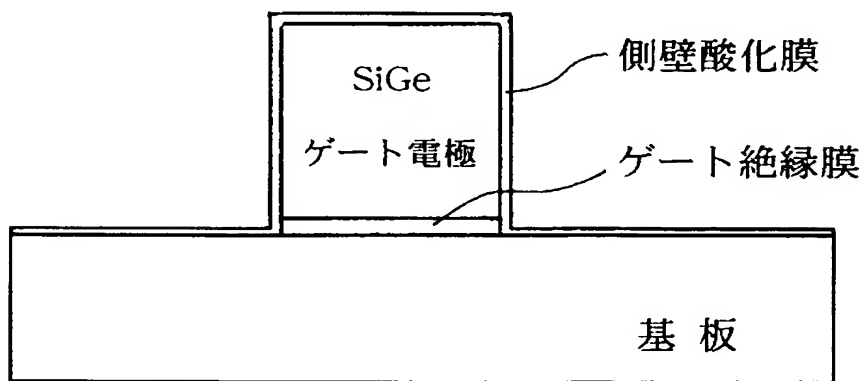
【図 9】



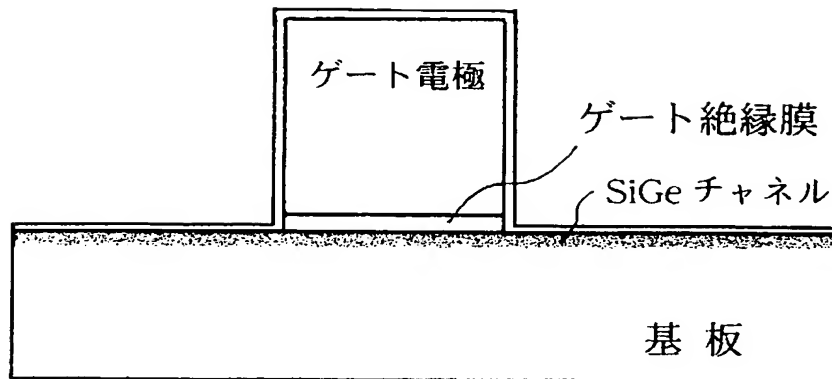
【図 10】



【図 11】



【図 12】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 少なくとも 2 種類の半導体からなる S i G e などの半導体層の表面を所望の形状に酸化処理を施す半導体装置及びこの酸化処理を効率的に行うことができる製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体基板上に形成された絶縁膜上に第 1 の半導体と第 2 の半導体からなる S i G e などの導電膜（ゲート電極 1 0 7）を形成し、次に、前記第 1 の半導体が酸化し前記第 2 の半導体が酸化しない雰囲気で熱処理を行って、前記導電膜上に前記第 1 の半導体の酸化膜（側壁絶縁膜 1 0 9）を形成する。また、半導体基板上の 2 種類以上の半導体からなる S i G e などの単結晶層の表面上に前記単結晶層に対する酸化種として還元剤及び酸化剤を含む雰囲気による熱酸化によって絶縁膜（ゲート酸化膜）を形成する。ゲート酸化膜形成後の薬液処理や熱処理耐性の高いゲート酸化膜が得られる。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 2 - 3 3 0 3 9 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 0 7 8]

1. 変更年月日

2 0 0 1 年 7 月 2 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

氏 名

株式会社東芝